

Silicon Diode

BYW75

500V / 3A

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BYW 72...BYW 76

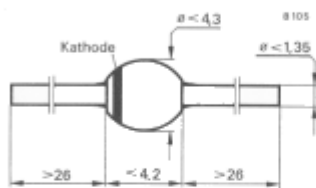
Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. für zeilenfrequenten Betrieb im Fernsehgerät und Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:

- Glaspasivierte Sperrschicht
- Kleiner Sperrstrom
- Hermetisch dichtes Gehäuse
- Soft recovery Verhalten

Abmessungen in mm



Sinterglasgehäuse
SOD 64
Gewicht max. 1,0 g

Bestempellung: Klartext oder TELEFUNKEN electronic Farbkodierung

Absolute Grenzdaten

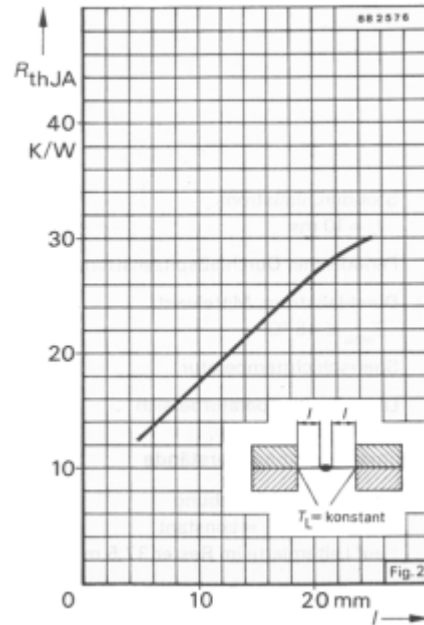
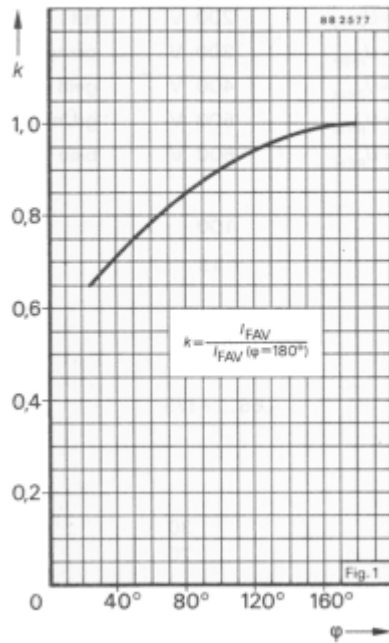
			Kathodenanschluß 1. Farbring violett	
			2. Farbring	
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung				
	BYW 72	$U_R = U_{RRM}$	200 V	rot
	BYW 73	$U_R = U_{RRM}$	300 V	orange
	BYW 74	$U_R = U_{RRM}$	400 V	gelb
	BYW 75	$U_R = U_{RRM}$	500 V	grün
	BYW 76	$U_R = U_{RRM}$	600 V	blau
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 10 \text{ ms}$		I_{FSM}	100	A
Periodischer Durchlaßspitzenstrom		I_{FRM}	15	A
Durchlaßstrom, Mittelwert $T_{amb} \leq 45 \text{ °C}$	Fig. 2, 5	I_{FAV}	3	A
Sperrschichttemperatur		T_j	175	°C
Lagerungstemperaturbereich		T_{stg}	- 65...+175	°C

Maximale Wärmewiderstände

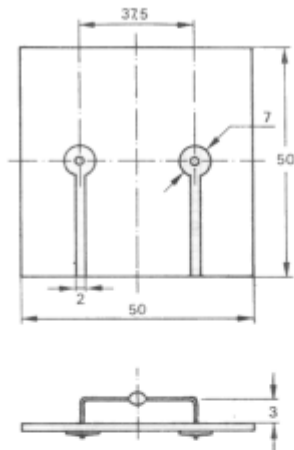
Sperrschicht-Umgebung $l = 25 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$	Fig. 2	R_{thJA}	30	K/W
auf Leiterplatte im Raster 37,5 mm	Fig. 3	R_{thJA}	70	K/W

BYW 72...BYW 76

Kenngrößen		Min.	Typ.	Max.	
$T_j = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung $I_F = 3\text{ A}$	U_F		0,95	1,1	V
Sperrstrom $U_R = U_{RRM}$ $U_R = U_{RRM}$, $T_j = 150\text{ °C}$	I_R		1	5	μA
	I_R		60	150	μA
Rückwärtserholzeit $I_F = 0,5\text{ A}, I_R = 1\text{ A}, I_R = 0,25\text{ A}$	t_{rr}			200	ns



BYW 72...BYW 76



Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstärke: 1,5 mm
 $R_{thJA} \leq 70 \text{ K/W}$

Fig.3

000075

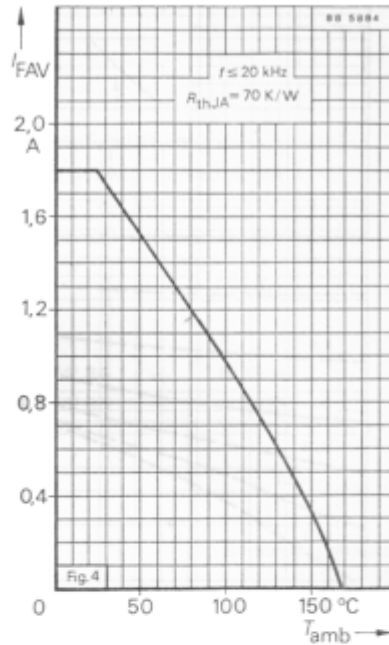


Fig.4

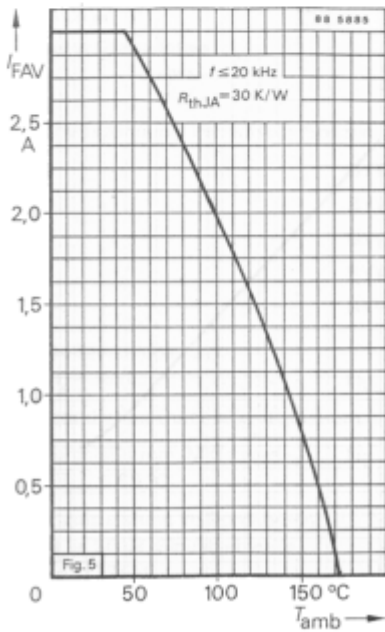


Fig.5

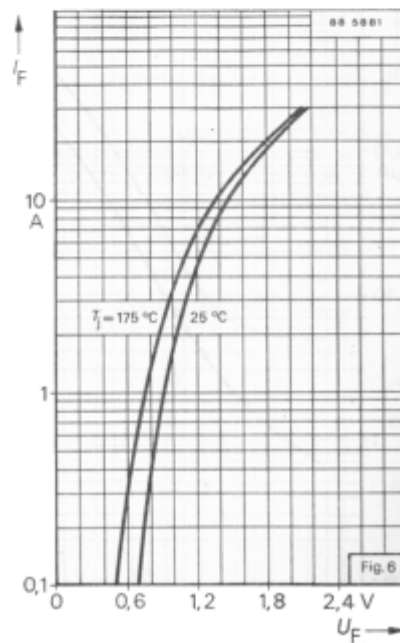


Fig.6

BYW 72...BYW 76

